



Features:

- **Speziell entwickelt für beschaltungslosen Betrieb**
- **Niedrige Verluste, weiches Ausschalten**
- **Volle Sperrfähigkeit bei 140°C mit 50Hz**
- **Hohes di/dt und niedriger Wärmewiderstand durch NTV-Verbindung zwischen Silizium und Mo-Trägerscheibe**
- **Elektroaktive Passivierung durch a-C:H**
- **Specially designed for snubberless operation**
- **Low losses, soft recovery**
- **Full blocking capability at 140°C with 50Hz**
- **High di/dt and low thermal resistance by using low temperature-connection NTV between silicon wafer and molybdenum**
- **Electroactive passivation by a-C:H**

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 0^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$ $f = 50\text{Hz}$	V_{RRM}	6500	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS forward current	$T_c = 60^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$	I_{FRMSM}	2230	A
Dauergrenzstrom mean forward current	$T_c = 85^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$ $T_c = 60^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$	I_{FAVM}	1130 1420	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, T_p = 10\text{ms}$	I_{FSM}	22	kA
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, T_p = 10\text{ms}$	I^2t	$2.4 \cdot 10^6$	A^2s
Max. Ausschaltverluste max. turn-off losses	$I_{FM} = 2500\text{A}, V_{CL} = 2800\text{V},$ clamp circuit $L_G \leq 0,25 \mu\text{H}, R_{CL} = 68\Omega$ $C_{CL} = 3\mu\text{F}, D_{CL} = 34\text{DSH65}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	W_{max}	5	MW



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Gleichsperrspannung continuous direct reverse voltage	failure rate $\lambda < 100$ estimate value	$V_{R(D)}$	typ. 3200	V
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, I_F = 2500A$	V_F	max 5.6	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}$	$V_{(TO)}$	2,19	V
Ersatzwiderstand forward slope resistance	$T_{vj} = T_{vj \max}$	r_T	1,37	m Ω
Durchlaßrechenkennlinie On-state characteristics for calculation $V_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$ 250 A $\leq i_F \leq$ 3200 A	$T_{vj} = T_{vj \max}$	A B C D	max. 0,698487 0,0002843 -0,042507 0,0908	
Spitzenwert der Durchlaßverzögerungsspannung peak value of forward recovery voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, di_F/dt = 5000A/\mu s$ $I_{FM} = 4000A$	V_{FRM}	typ. 360	V
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_R = V_{RRM}$	i_R	150	mA
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_{FM} = 2500A, V_{CL} = 2800V,$ clamp circuit $L_{\sigma} \leq 0,25 \mu H, R_{CL} = 68\Omega$ $C_{CL} = 3\mu F, D_{CL} = 34DSH65$ $T_{vj} = T_{vj \max}$	I_{RM}	max 1300	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge		Q_r	max 3500	μAs
Ausschaltverlust Energie turn-off energy		E_{off}	8	Ws
Abklingsanfttheit reverse recovery softness factor $F_{RRS} = \frac{(di_{rr}/dt)_{i=0}}{(di_{rf}/dt)_{\max}}$	$I_{FM} = 2500A, V_R = 2800V$ $-di_{rr}/dt_{(i=0)} = 1000A/\mu s, dt = 200ns$ $T_{vj} = T_{vj \max}$	F_{RRS}	typ. 1,6	

Technische Information / Technical Information

Schnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode

D 1131 SH 65T

eupec

SH



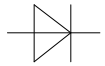
Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max 0.0075 max 0.014 max 0.016	°C/W °C/W °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single sided	R_{thCK}	max 0.0025 max 0.005	°C/W °C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj \max}$	140	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c \text{ op}}$	0...+140	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+150	°C

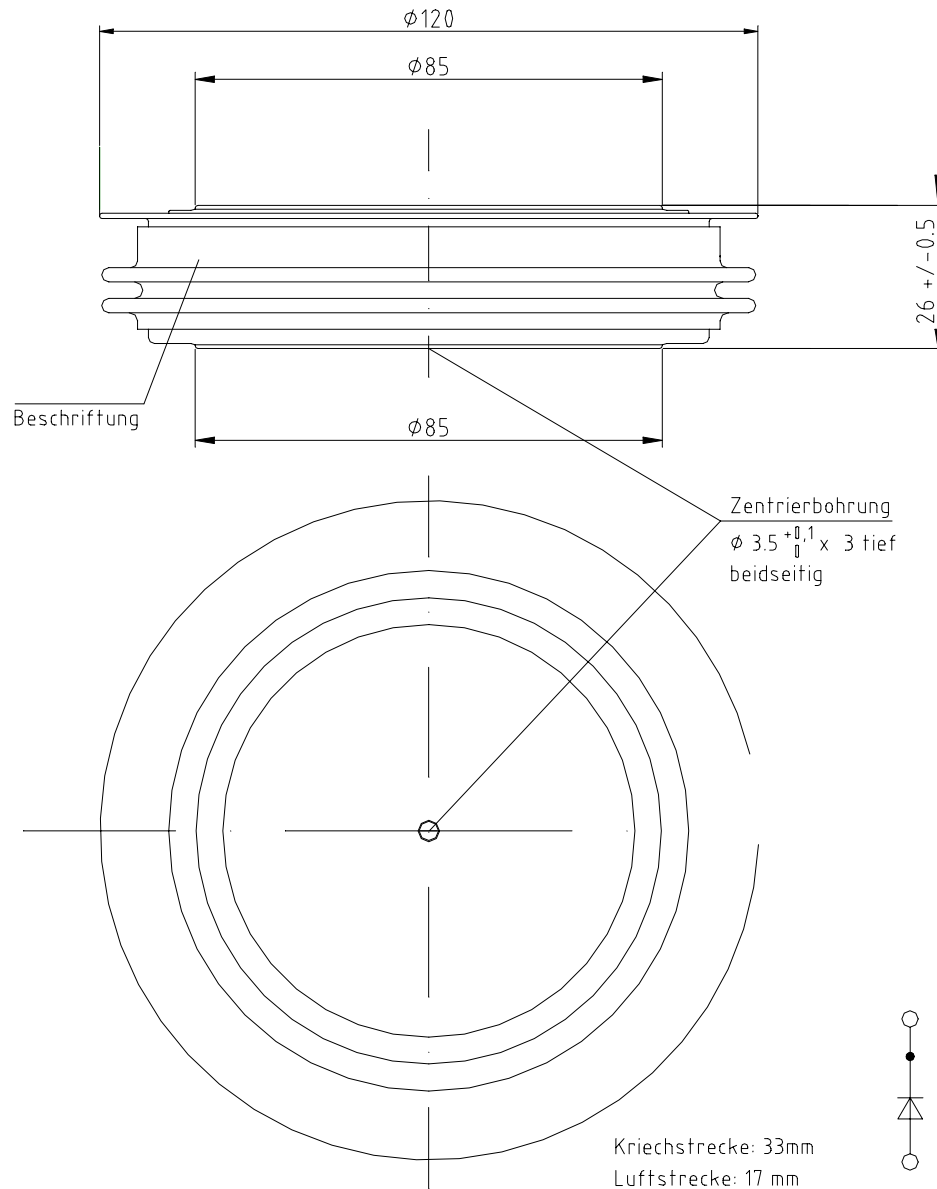
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3	
Si - Element mit Druckkontakt Si - pellet with pressure contact			76DSH65	
Anpreßkraft clampig force		F	36...52	kN
Gewicht weight		G	typ 1200	g
Kriechstrecke creepage distance			33	mm
Luftstrecke air distance			17	mm
Feuchtekategorie humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s ²

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes

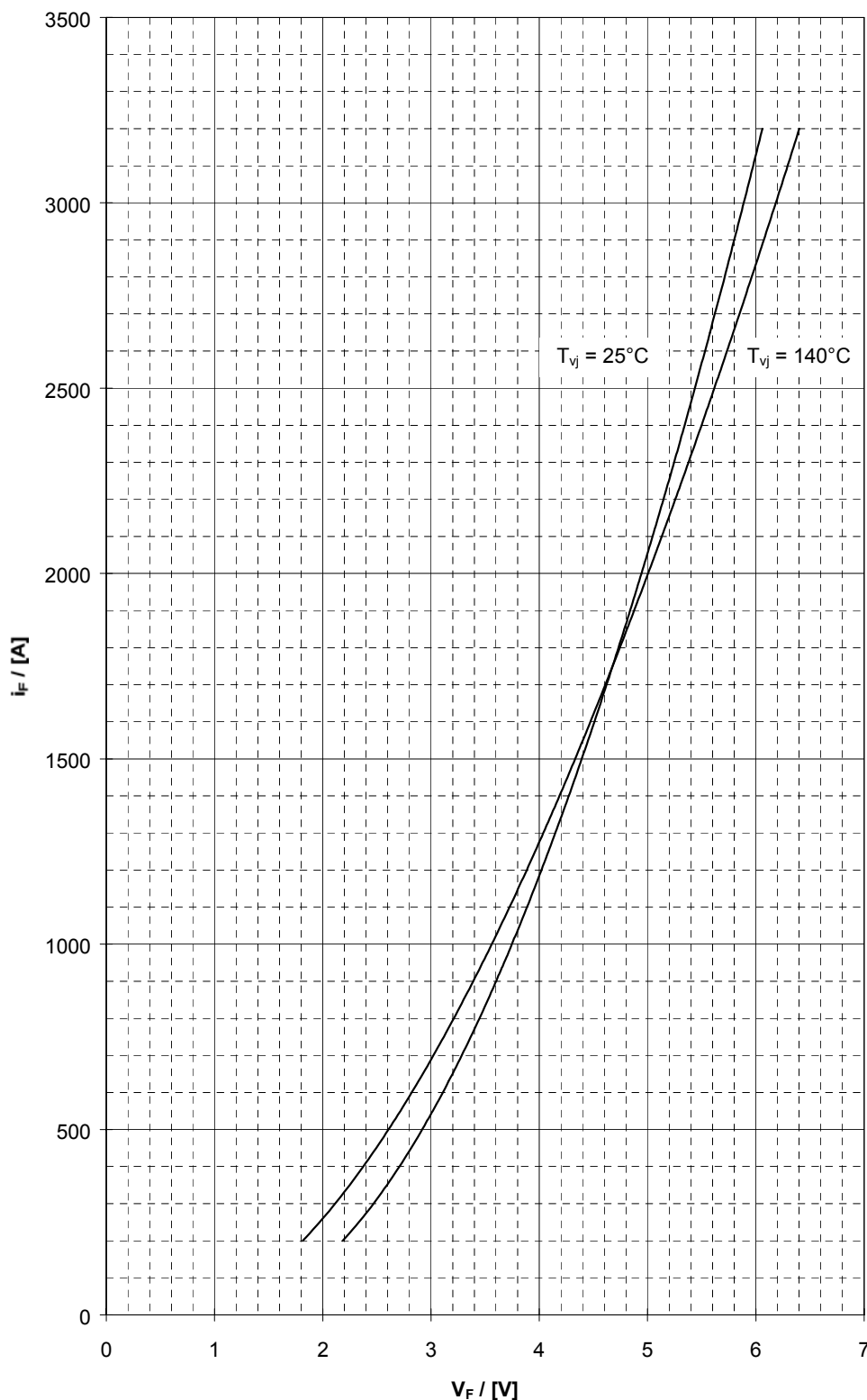


Maßbild / Outline drawing





Durchlaßkennlinie / On-state characteristics $i_F = f(V_F)$
upper limit of scatter range

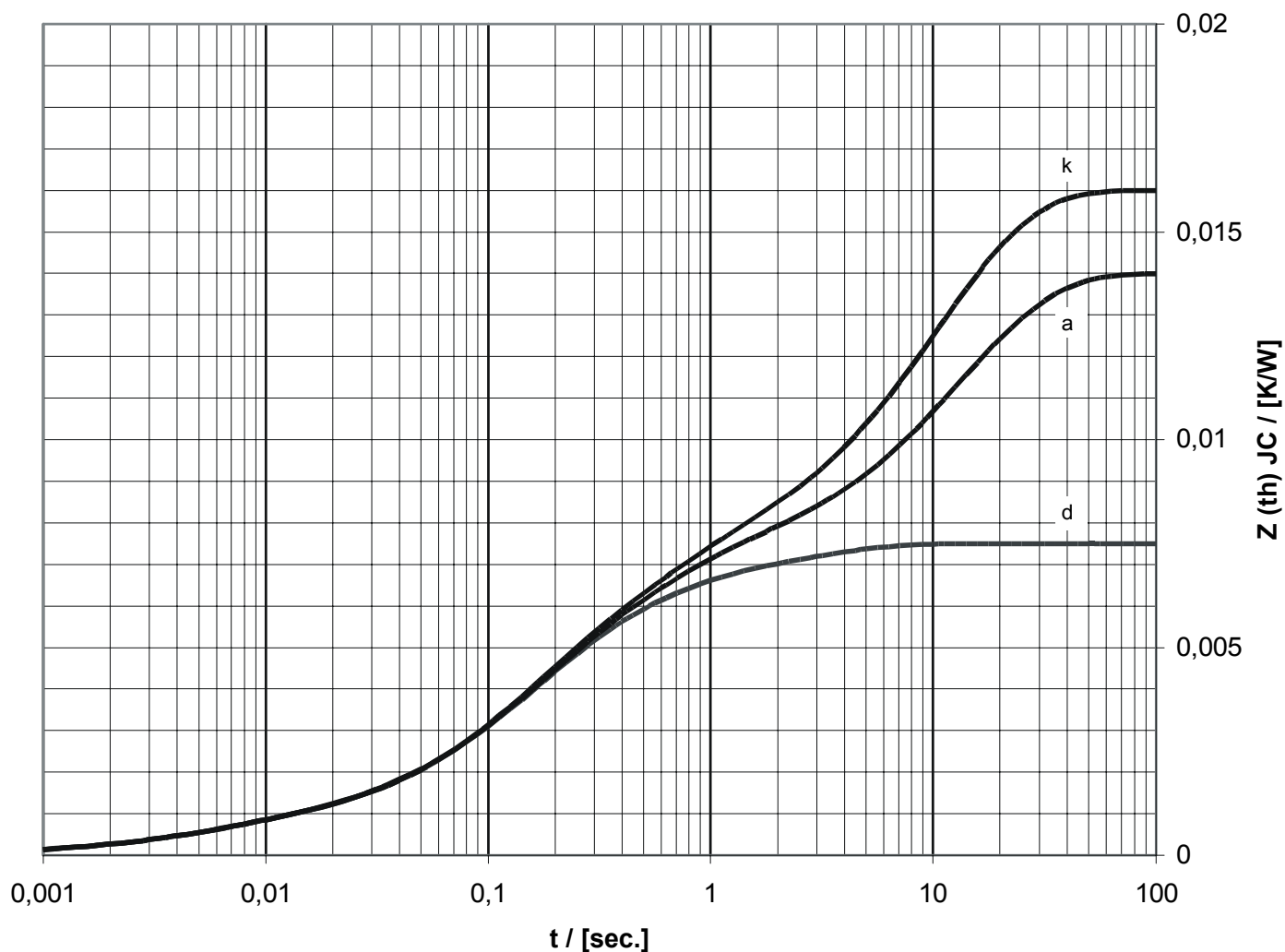




Transienter innerer Wärmewiderstand Transient thermal Impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$

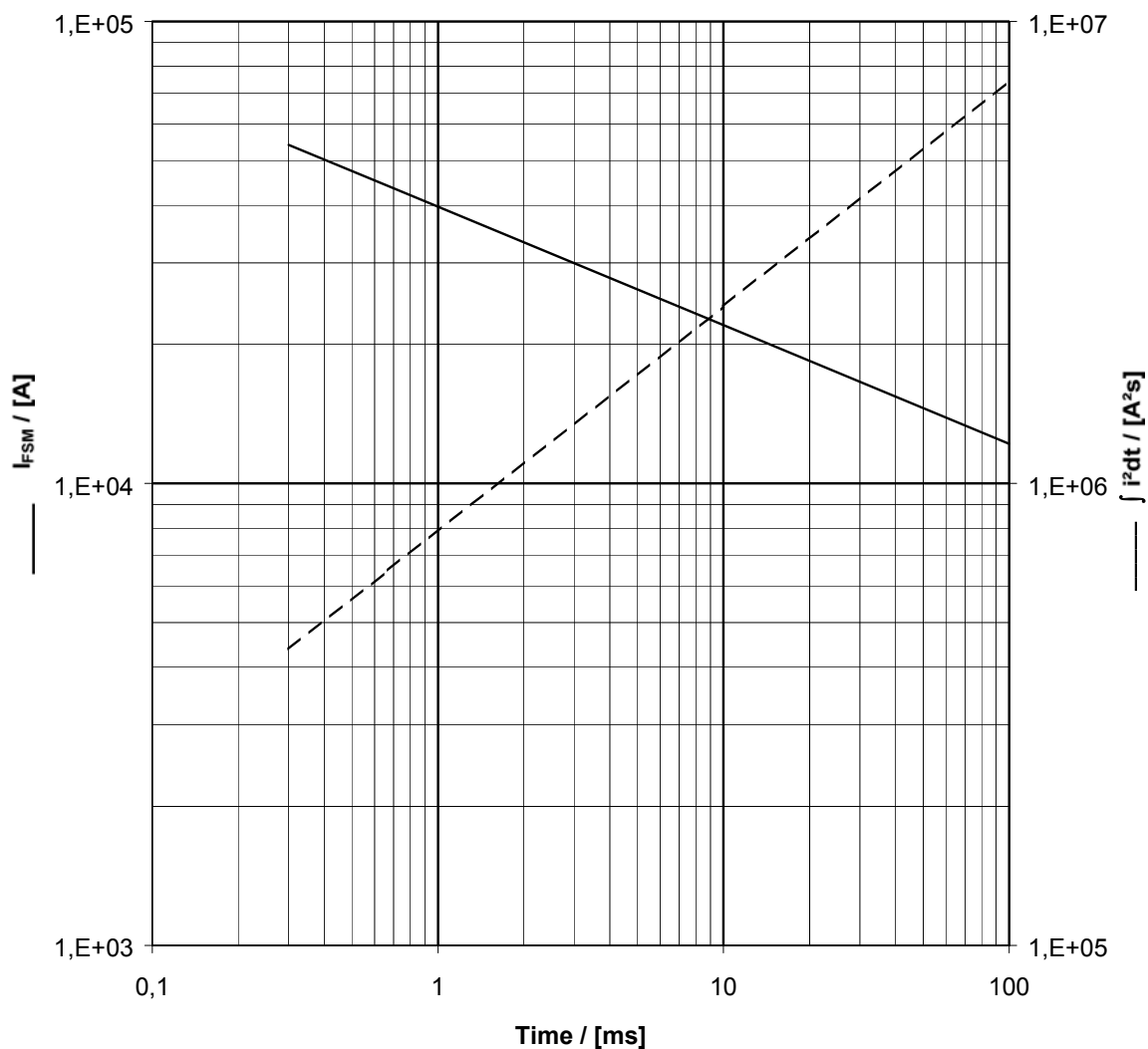
$$Z_{th,JC}(t) = \sum_n R_{th,n} \cdot (1 - e^{-t/\tau_n})$$

	Double side cooled		Anode side Cooled		Cathode side cooled	
	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]
1	0,0011	2,35	0,007	13,4	0,009	10,6
2	0,0022	0,39	0,0028	0,5	0,0028	0,5
3	0,0028	0,12	0,0028	0,12	0,0028	0,12
4	0,0008	0,16	0,0008	0,16	0,0008	0,16
5	0,0006	0,005	0,0006	0,005	0,0006	0,005
Σ	0,0075	-	0,014	-	0,016	-



**Stoßstrom / Grenzlastintegral Charakteristik**
Surge current / I²t value characteristics

$$I_{FSM} = f(t_p) / \int i^2 dt = f(t_p)$$

Sine half-wave, $T_{vj}=140\text{ }^{\circ}\text{C}$, $v_R = 0$ 



Sperrverzögerungsladung / recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

Upper limit of scatter range for $V_F = 5,1V$ @2500A, 140°C

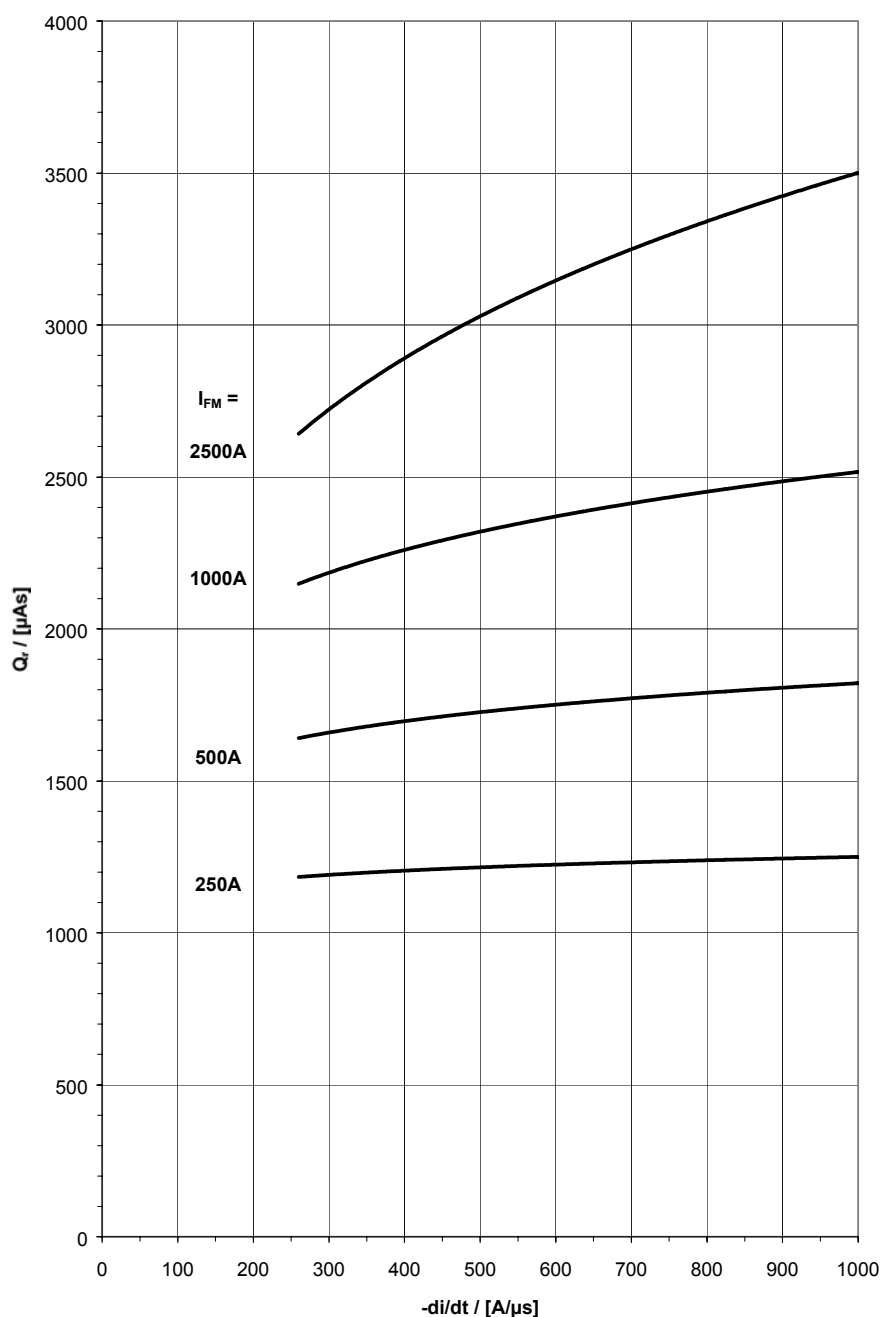
Conditions:

$T_{vj} = 140^\circ C$

Parameter: I_{FM}

clamping circuit $C_{CL} = 3 \mu F$ $R_{CL} = 68\Omega$ 34DSH65

$V_{CL} = 2800 V$





Rückstromspitze / peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$

Upper limit of scatter range for $V_F = 5,1V @ 2500A, 140^\circ C$

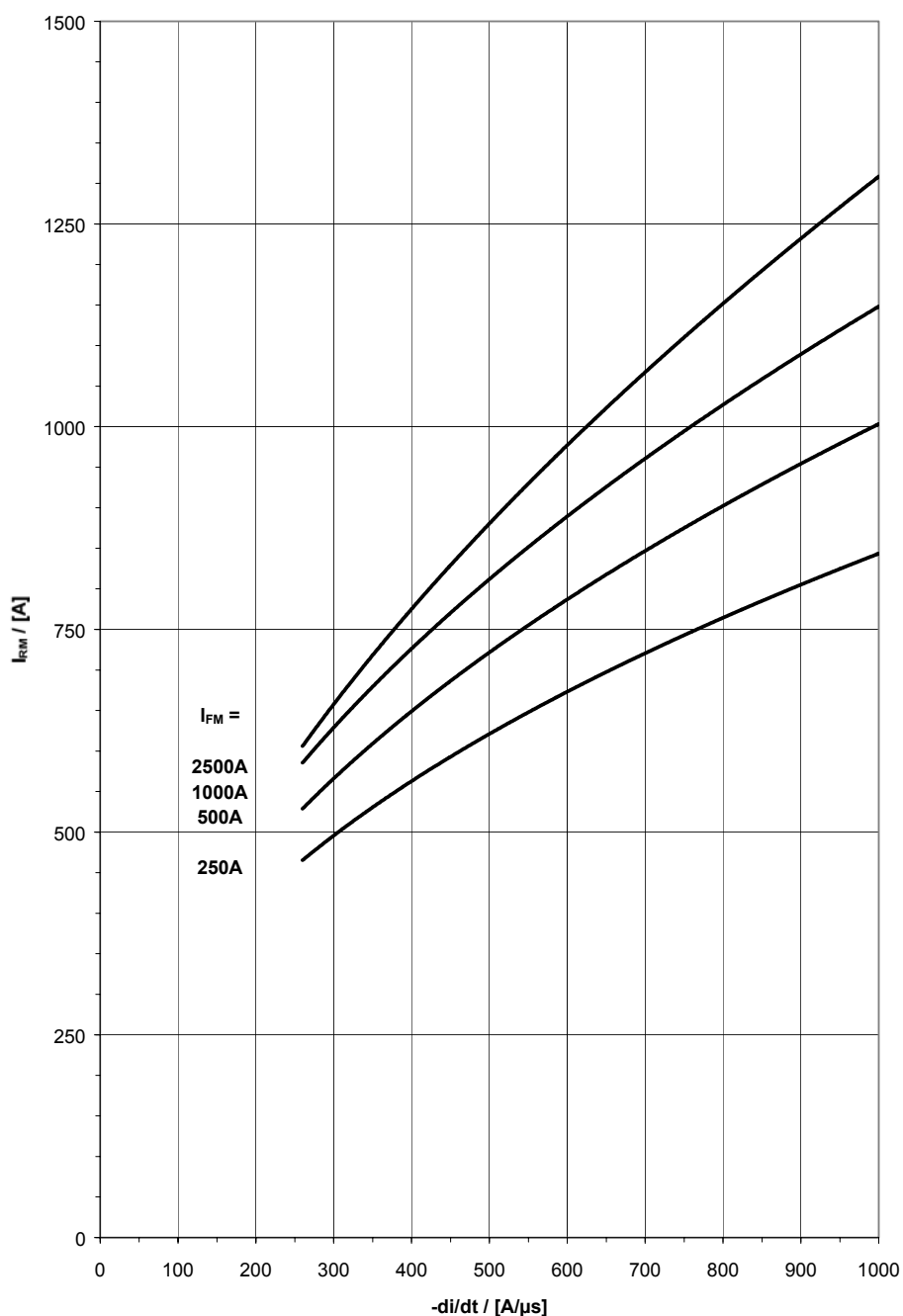
Conditions:

$T_{vj} = 140^\circ C$

Parameter: I_{FM}

clamping circuit $C_{CL} = 3 \mu F$ $R_{CL} = 68 \Omega$ 34DSH65

$V_{CL} = 2800 V$





Ausschaltverlust Energie / turn-off energy $E_{off} = f(-di/dt)$

Upper limit of scatter range for $V_F = 5,1V$ @2500A, 140°C

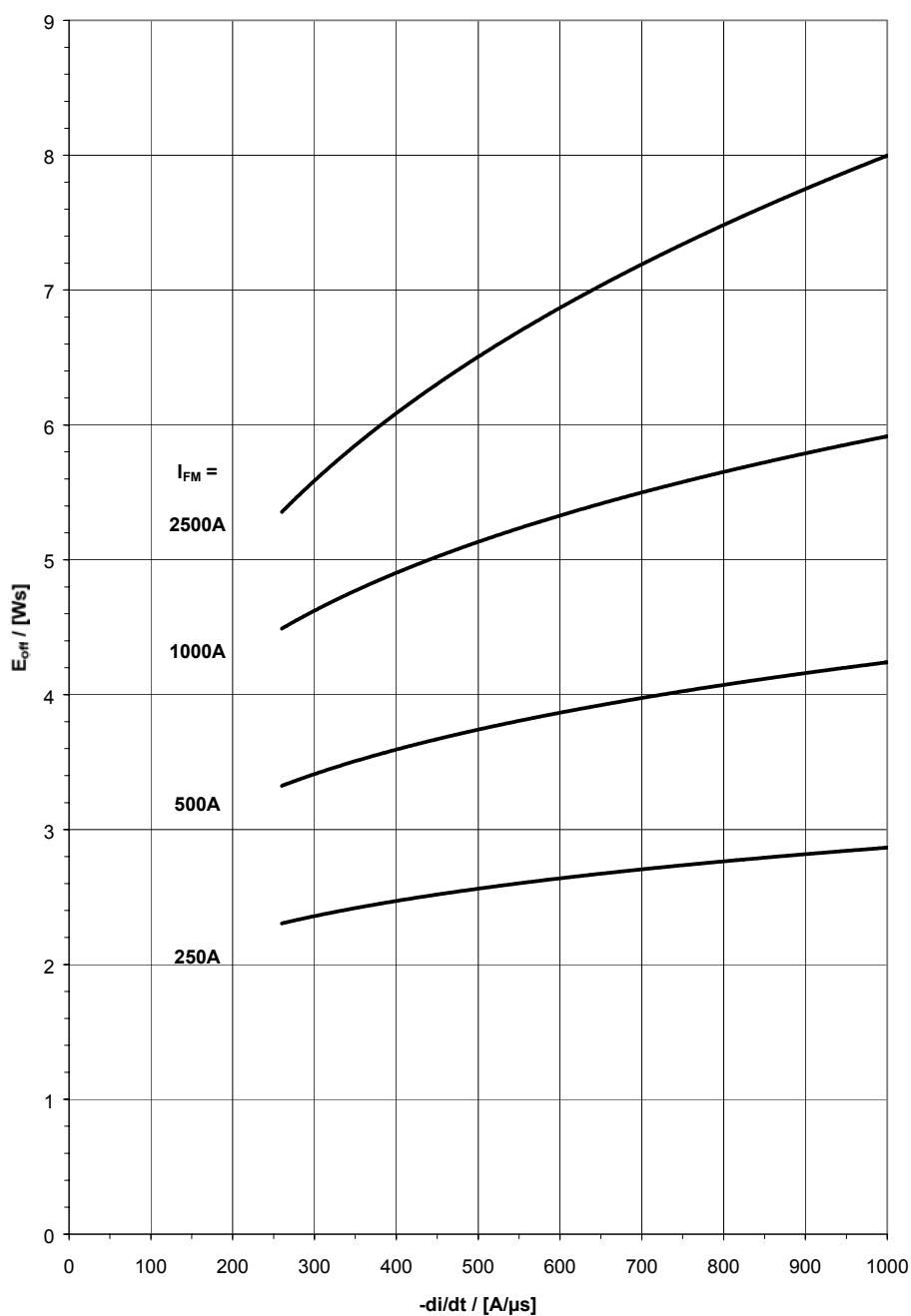
Conditions:

$T_{vj} = 140^\circ C$

Parameter: I_{FM}

clamping circuit $C_{CL} = 3 \mu F$ $R_{CL} = 68 \Omega$ 34DSH65

$V_{CL} = 2800 V$





Spitzen-Durchlassverzögerungsspannung
peak forward recovery voltage $V_{FRM} = f (di_F/dt)$
typische Abhängigkeit / typical dependence

$T_{vj} = 140^{\circ}\text{C}$, $I_{FM} = 4000\text{A}$

